

Изобретение относится к области нетрадиционных источников электрической энергии, в частности к преобразователям солнечной энергии.

Солнечный элемент включает монокристалл Si с потенциальным барьером типа МОС или Шотки на его лицевой поверхности, а также с нанесенными омическими контактами на лицевой и тыльной поверхностях. На лицевой и тыльной поверхностях монокристалла сформирована пористая нанометрическая структура, а область объемного заряда потенциального барьера включает пористую нанометрическую структуру.